

用于 3G 和 4G 射频 (RF) 功率放大器的 LM3269 无缝转换降压-升压转换器

查询样品: [LM3269](#)

特性

- 由单节锂离子电池供电运行: **2.7V 至 5.5V**
- 可调节输出电压: **0.6V 至 4.2V**
- 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉宽调制 (PWM) 变化
- 针对 $V_{BATT} \geq 3.0V$, $V_{OUT} = 3.8V$ 时最大 **750mA** 的最大负载能力
- **2.4MHz** (典型值) 开关频率
- 无缝降压-升压模式转换
- 快速输出电压转换: **10μs** 内可完成从 **1.4V 至 3.0V** 的转换
- 高效: 典型值 **95%** 达到此效率的 $V_{BATT} = 3.7V$, $V_{OUT} = 3.3V$, 电流为 **300mA**
- 输入过流限制
- 内部补偿
- **12** 凸点芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装

应用范围

- 用于 **3G/4G** 功率放大器的电源
- 手机
- 便携式硬盘驱动
- 掌上电脑 (PDA)

典型应用电路

说明

LM3269 是一款降压-升压 DC/DC 转换器, 此转换器被设计用于生成高于或低于一个指定输入电压的输出电压, 并且特别适合于由一个单节锂离子电池供电的便携式应用。

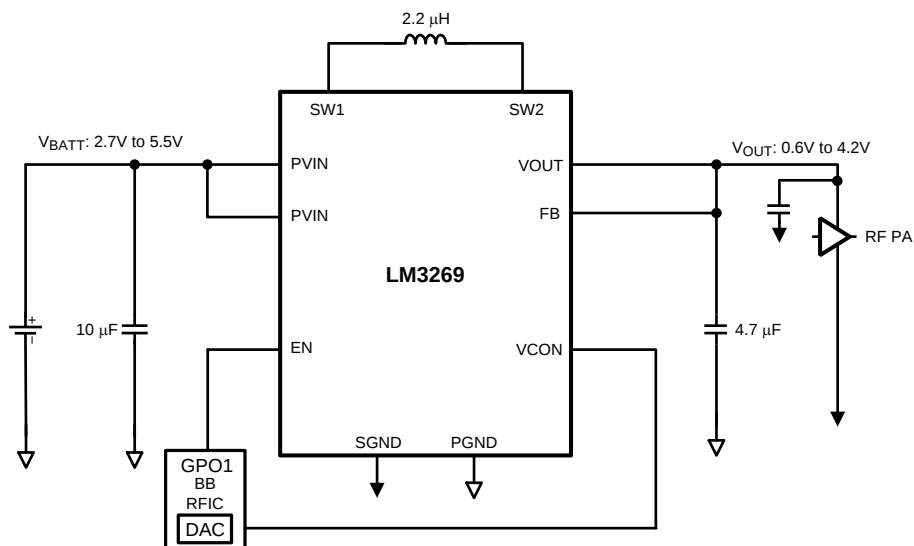
LM3269 在完全同步运行中的典型开关频率为 2.4MHz 并提供降压和升压运行方式间的无缝转换。为了提高效率并节省低功耗 RF 传输模式期间的电流, LM3269 运行在节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。

此功率转换器拓扑结构只需一个电感器和两个电容器。一个独特的内部电源开关拓扑结构可实现较高的总体效率。

LM3269 针对降压和升压模式操作而进行了内部补偿, 从而提供了最佳的瞬态响应。

LM3269 采用大小为 2.0mm x 2.5mm x 0.6mm 的 12 凸点 DSBGA 封装。

如果您希望在系统设计中使 LM3269, 请查看本文档末尾的印刷电路板 (PCB) 布局布线注意事项部分。



Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

All trademarks are the property of their respective owners.

PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of the Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

Copyright © 2011–2013, Texas Instruments Incorporated
English Data Sheet: [SNVS793](#)

连接图和封装标记信息

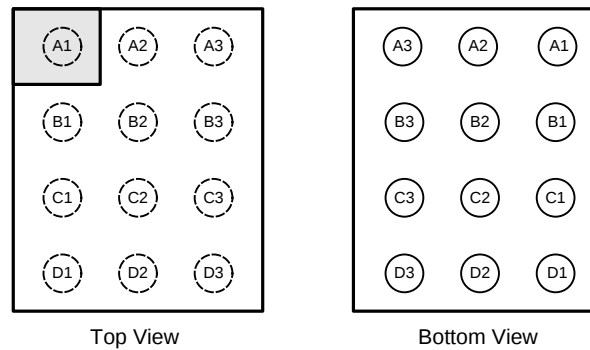


Figure 1. 12 凸点薄型芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装，大凸点

引脚说明

引脚 #	名称	说明
A1	NC	无连接。将这个引脚保持悬空；不要连接至 PVIN 或 PGND。
B1	VCON	电压控制模拟输入。VCON 控制脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 模式中的输出电压。
C1	FB	到误差放大器的反相输入的反馈输入。将输出电压直接连到负载点上的这个节点。
D1	VOUT	LM3269 的经稳压输出电压。将它连接到与接地 (GND) 相连的 4.7μF 陶瓷输出滤波器电容器上。
A2	NC	无连接 将这个引脚保持悬空，不要连接到 PVIN 或 PGND。
B2	EN	使能引脚。将这个引脚的电压拉高到高于 1.2V 的水平来启用部件。
C2	SGND	针对模拟电路和控制电路的信号接地。
D2	SW2	用于内部电源开关的切换引脚。在 SW1 和 SW2 之间连接电感器。
A3	PVIN	功率 MOSFET 输入和电源电流输入引脚。可选低通滤波有助于降压和降压-升压模式减少辐射电磁干扰 (EMI) 和降噪。
B3	PVIN	功率 MOSFET 输入和电源电流输入引脚。可选低通滤波有助于降压和降压-升压模式减少辐射电磁干扰 (EMI) 和降噪。
C3	SW1	用于内部电源开关的切换引脚。在 SW1 和 SW2 之间连接电感器。
D3	PGND	针对功率 MOSFET 和栅极驱动电路的电源接地。



These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.

最大绝对额定值⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

PVIN, VOUT 至 GND	-0.2V 至 +6.0V
EN, VCON 至 SGND, PGND	-0.2V 至 (PVIN+0.2V)/6.0V 最大值
FB 至 PGND	-0.2V 至 (VOUT+0.2V)/6.0V 最大值
SW1, SW2	(PGND-0.2V) 至 (PVIN+0.2V)/6.0V
持续功率耗散 ⁽⁴⁾	受到内部限制
结温 (T _{J-MAX})	+150°C
储存温度范围	-65°C 至 +150°C
最大引线温度 (焊接时)	请参阅 ⁽⁵⁾
静电放电 (ESD) 额定值 ⁽⁶⁾ 人体模型	2kV

- (1) 超出最大绝对额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在应力额定值下的工作情况，对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的运行条件下标明的任何其它条件下的操作，在此并未说明。长时间处于最大绝对额定情况下会影响设备的可靠性。
- (2) 所有电压相对于 GND 引脚上的电压。
- (3) 如果需要军用/航天专用器件，请与德州仪器 (TI) 销售办公室/分销商联系以了解可用性和技术规格。
- (4) 内部热关断电路保护器件不受永久损坏。热关断在 T_J=150°C (典型值) 时起作用并在 T_J=125°C (典型值) 时放电
- (5) 要获得详细的焊接技术规格和信息，请参考德州仪器 (TI) 操作说明书 **1112** : DSBGA 晶圆级芯片封装(SNVA009)。
- (6) 人体模型是一个通过 1.5kΩ 电阻器对每个引脚放电的 100pF 电容器。(MIL-STD-883 3015.7)

运行额定值⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

输入电压范围	2.7V 至 5.5V
输出电压范围	0.6V 至 4.2V
推荐负载电流	0 至 750mA
结温 (T _J) 范围	-30°C 至 +125°C
环境温度 (T _A 范围 ⁽⁴⁾)	-30°C 至 +85°C

- (1) 超出最大绝对额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在应力额定值下的工作情况，对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的运行条件下标明的任何其它条件下的操作，在此并未说明。长时间处于最大绝对额定情况下会影响设备的可靠性。
- (2) 所有电压相对于 GND 引脚上的电压。
- (3) 绝对最大额定值表示超过这些额定值有可能对组建造成损坏。运行额定值是器件指定的运行条件。运行额定值并不意味着已经验证的性能限值。对于性能限值和相关的测试条件，请参见电气特性表。
- (4) 在出现耗散功率较高和/或封装热阻较差情况的应用中，可能需要降低最高额定环境温度。最大环境温度 (T_{A-MAX}) 取决于最大运行结温 (T_{J-MAX-OP}=125°C)，应用中器件的最大功率耗散 (P_{D-MAX}) 以及应用中的部件/封装的结至环境热阻抗 (θ_{JA})，计算方程式如下：T_{A-MAX}= T_{J-MAX-OP}-(θ_{JA}× P_{D-MAX})。

热属性

结至环境热阻抗 (θ _{JA})，YZR 封装 ⁽¹⁾	85°C/W
--	--------

- (1) 结至环境热阻抗与应用和电路板布局布线密切相关。对于存在较高最大功率耗散的应用，必须对电路板设计中的散热问题予以特别关注。结至环境热阻抗 (θ_{JA}) 由热建模结果而定，热建模的执行条件和步骤在 JEDEC 标准 JESD51-7 中给出。

电气特性⁽¹⁾⁽²⁾

标准字体显示的是 $T_A = T_J = 25^\circ\text{C}$ 时的限值。用黑体字显示的限值适用于整个运行环境温度范围 ($-30^\circ\text{C} \leq T_J = T_A \leq +85^\circ\text{C}$) 除非另外注明，否则技术规格适用于 LM3269 典型应用电路：PVIN=EN=3.6V。

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值 40V	单位
V_{FB} , 最小值	最小 FB 电压	VCON=0.2V	0.53	0.60	0.67	V
V_{FB} , 最大值	最大 FB 电压	VCON=1.4V	4.13	4.2	4.27	
I_{Q_PWM}	静态电流	无切换 ⁽³⁾		0.9	1.2	mA
I_{SHDN}	关断电源电流	EN=0V, VCON=0V, SW1=SW2=V _{OUT} =0V		0.02	5.0	μA
I_{LIM_L}	输入电流限值 (大值)	开环路 ⁽⁴⁾ VCON=1.2V	1500	1700	1900	mA
I_{LIM_S}	输入电流限值 (小值)	开环路 ⁽⁴⁾ VCON=0.2V	750	850		
F_{OSC_PWM}	内部振荡器频率	PWM	2.1	2.4	2.7	MHz
增益	内部增益 ⁽⁵⁾	$0.2V \leq VCON \leq 1.4V$		3		V/V
I_{EN}	EN 引脚下拉电流			5	10	μA
I_{VCON}	VCON 引脚泄露电流		-1		+1	
V_{IH}	针对 EN 的逻辑高电平输入阈值		1.2			V
V_{IL}	针对 EN 的逻辑低电平输入阈值				0.6	
$I_{OUT_LEAKAGE}$	到降压-升压 VOUT 引脚的泄露电流	EN=0, V _{OUT} ≤4.2V PVIN≤5.5V			5	μA

(1) 所有电压相对于 GND 引脚上的电压。

(2) 最小和最大限值由设计、测试或统计分析指定。典型值未经验证，但是的确代表了大多数可能的标准。

(3) 这里的 I_Q 是在此部件未切换时指定的值。对于无负载时的运行静态电流，请参考数据表曲线图。

(4) 电气特性标准的参数在开环路条件 (PVIN=3.6V 时) 进行测试。

(5) 要计算 V_{OUT} ，使用以下方程式： $V_{OUT} = VCON \times 3$ 。

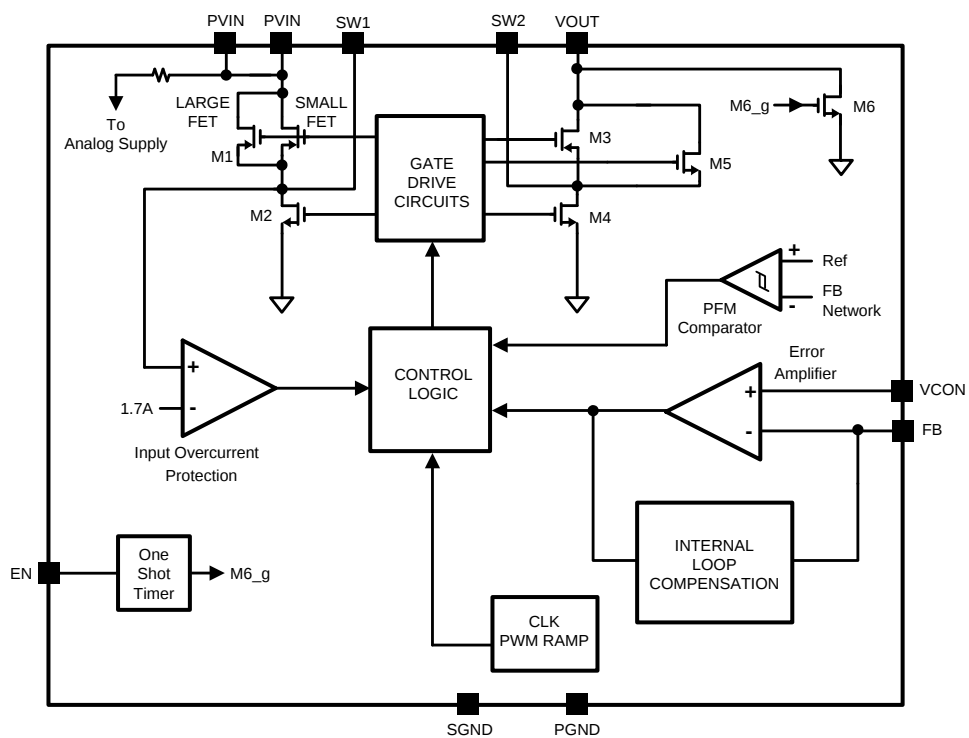
系统特点

以下由设计和验证指定的技术规格表条目给出了典型应用电路中所使用的组件值

($L=2.2\mu\text{H}$, $\text{DCR}=110\text{m}\Omega$, MIPSZ2520D2R2/FDK; $C_{\text{IN}}=10\mu\text{F}$, 6.3V, C1608X5R0J106K/TDK (0603); $C_{\text{OUT}}=4.7\mu\text{F}$, 6.3V, C1608X5R0J475M/TDK (0603)。这些参数未经量产测试验证。黑体字显示的最小和最大限值适用于整个运行环境温度范围 ($-30^{\circ}\text{C}\leq T_{\text{A}}\leq 85^{\circ}\text{C}$) 以及 $V_{\text{BATT}}=\text{PVIN}=2.7\text{V}$ 至 5.5V 的情况, 除非另外注明。

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值 40V	单位
T_{ON}	接通时间 (对于输出从 0V 达到 90% x 3.5V 的时间)	EN=L 到 H, $V_{\text{BATT}}=3.7\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=3.5\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=0\text{mA}$		35	50	μs
$I_{\text{OUT_MAX}}$	最大输出电流	$V_{\text{BATT}}\geq 3.0\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=3.8\text{V}$	750			mA
$F_{\text{OSC_PFM}}$	PFM 运行频率	$V_{\text{BATT}}=3.7\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=0.6\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=13\text{mA}$		63		kHz
D_{MAX}	最大占空比	升压			50	%
		降压			100	
$V_{\text{CON_LIN}}$	VCON 线性	$0.2\text{V}\leq V_{\text{CON}}\leq 1.4\text{V}$	-2.5		+2.5	%
$V_{\text{O_RIPPLE}}$	纹波电压	$V_{\text{BATT}}\geq 3.2\text{V}$, $0.6\leq V_{\text{OUT}}\leq 4.2\text{V}$, $0\text{mA}\leq I_{\text{OUT}}\leq 430\text{mA}$, $T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$		15	50	mV
	PFM 纹波	$V_{\text{OUT}}=0.6\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=5\text{mA}$		45		
	模式转换中的纹波电压	$V_{\text{BATT}}=3.0\text{V}$ 至 5.0V , $T_{\text{R}}=T_{\text{F}}=30\text{s}$, $3.3\text{V}\leq V_{\text{OUT}}\leq 4.2\text{V}$			50	
ΔV_{OUT}	线路调节	$V_{\text{BATT}}=2.7\text{V}$ 至 4.7V , $V_{\text{OUT}}=3.8\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=500\text{mA}$			10	mV
	负载调节	$I_{\text{OUT}}=0\text{mA}$ 至 500mA , $V_{\text{BATT}}=2.7\text{V}$ 至 4.7V			20	
$V_{\text{OUT_TR}}$	VOUT 上升时间 VCON 变化为 90%	$V_{\text{BATT}}=3.2\text{V}$ 至 4.7V , $V_{\text{OUT}}=1.4\text{V}$ 至 3.0V , $0.1\mu\text{s}<T_{\text{r_VCON}}<1\mu\text{s}$ $R_{\text{负载}}=11.4\Omega$		10		μs
η	效率	$V_{\text{BATT}}=3.7\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=0.6\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=10\text{mA}$		61		%
		$V_{\text{BATT}}=3.7\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=1.0\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=20\text{mA}$		78		
		$V_{\text{BATT}}=3.7\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=1.4\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=50\text{mA}$		85		
		$V_{\text{BATT}}=3.7\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=2.7\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=200\text{mA}$		95		
		$V_{\text{BATT}}=3.7\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=3.3\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=480\text{mA}$		94		
		$V_{\text{BATT}}=3.0\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=3.6\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=200\text{mA}$		95		

方框图



典型性能特点

($P_{VIN}=E_N=3.6V$ 并且 $T_A=25^{\circ}C$, 除非另外注明)

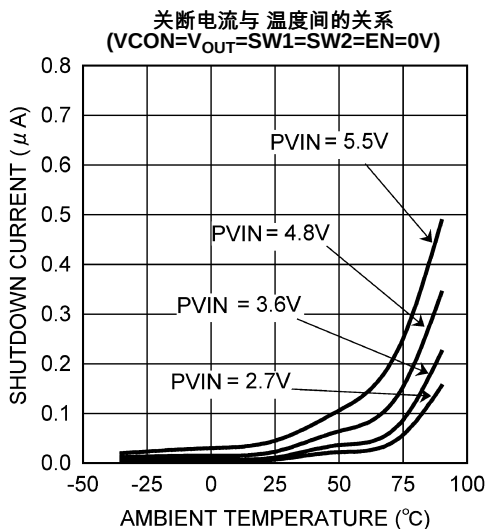


Figure 2.

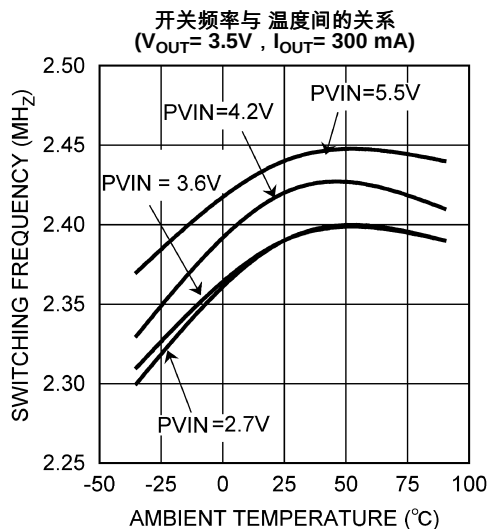


Figure 3.

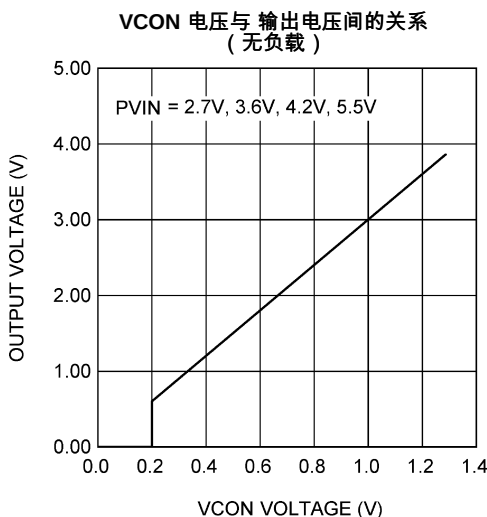


Figure 4.

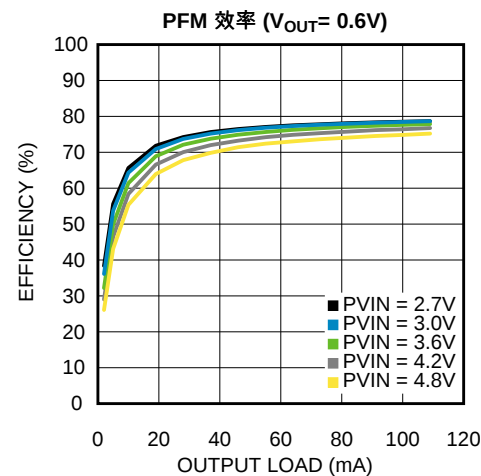


Figure 5.

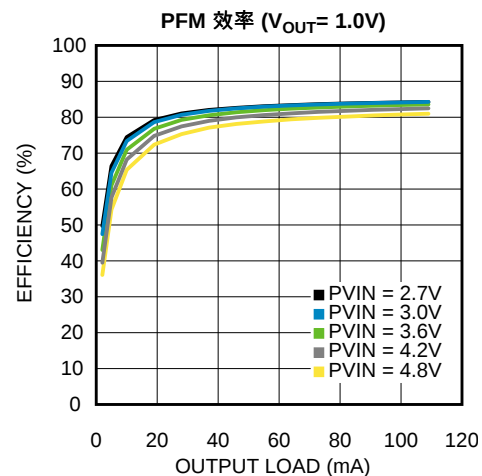


Figure 6.

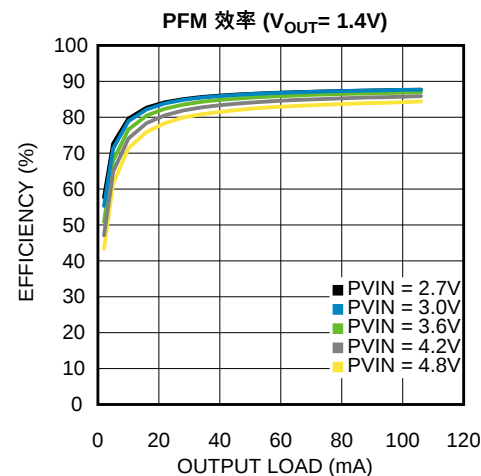


Figure 7.

典型性能特点 (continued)

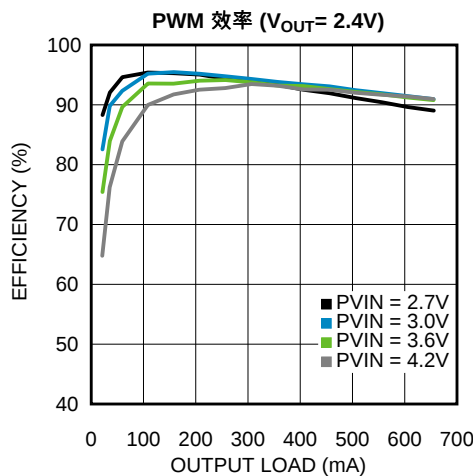
($P_{VIN}=EN=3.6V$ 并且 $T_A=25^{\circ}C$, 除非另外注明)

Figure 8.

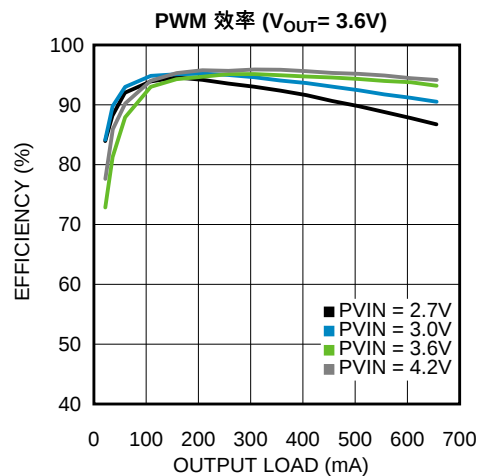


Figure 9.

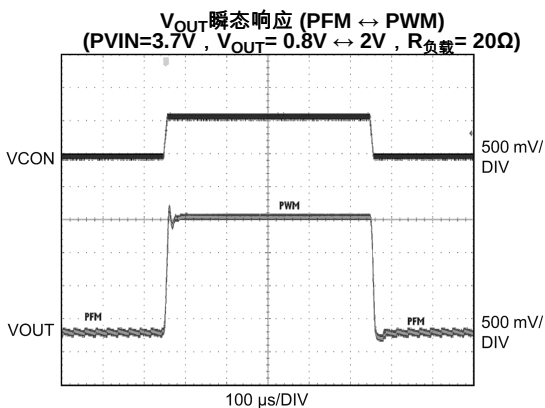


Figure 10.

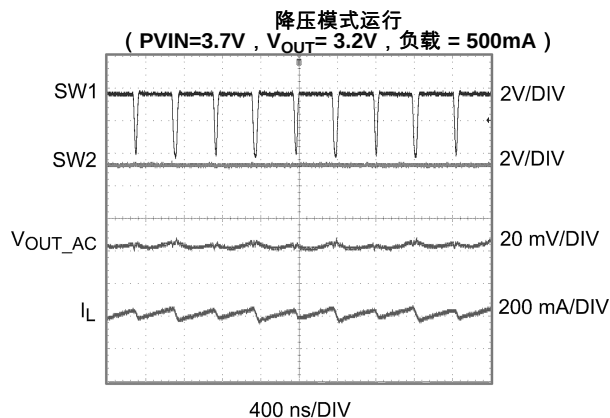


Figure 11.

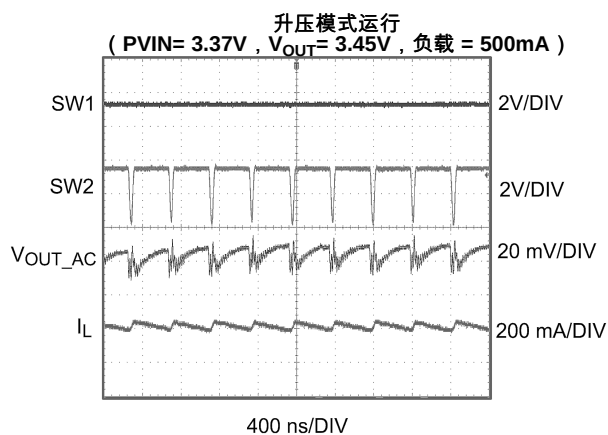


Figure 12.

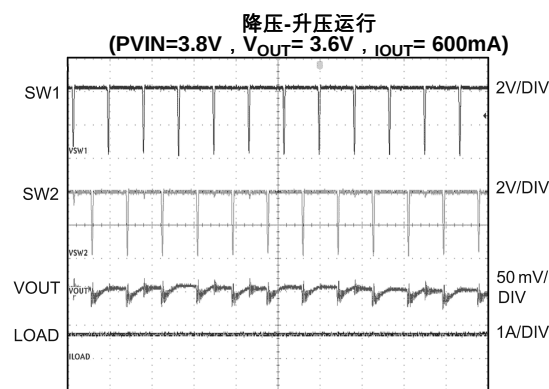


Figure 13.

典型性能特点 (continued)

($P_{VIN}=EN=3.6V$ 并且 $T_A=25^{\circ}C$, 除非另外注明)

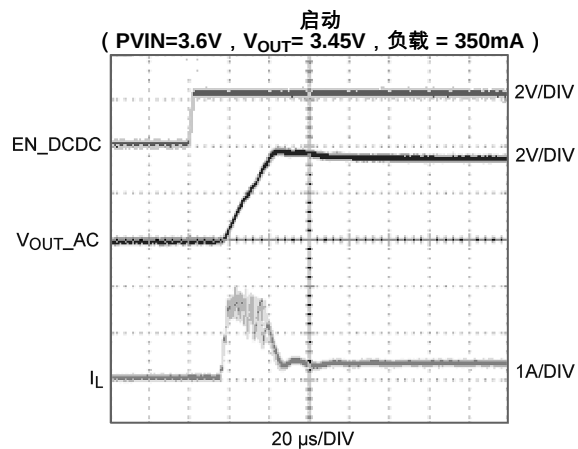


Figure 14.

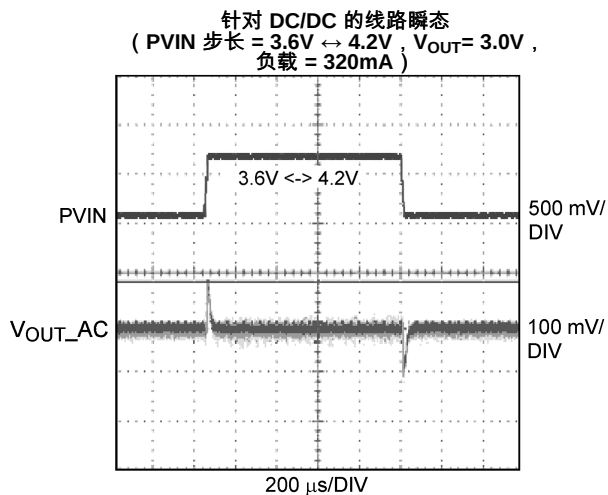


Figure 15.

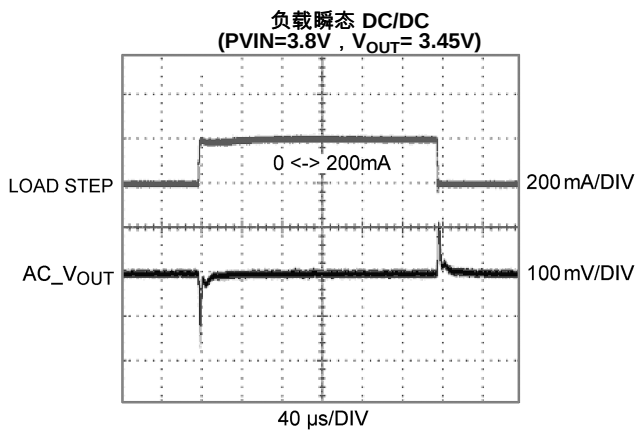


Figure 16.

运行说明

LM3269 降压-升压转换器为手机、便携式通信装置和类似电池供电 RF 器件中的 RF 功率放大器 (PA) 提供高效率、低噪声电源。它被设计成在由单节锂离子电池供电时使得 RF PA 能够在广泛的功率水平上以最大频率运行。LM3269 的功能就是提供一个低于或高于输入电池电压的输出电压以使得 PA 能够在广泛的电池电压范围内实现高线性运行,从而扩展电池的可用电压范围。转换器反馈环路针对降压和升压运行进行内部补偿,此架构因此能够提供降压和升压运行模式之间的无缝转换。为了提高效率并节省低功耗 RF 传输模式期间的电流,LM3269 运行在节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。通过调整控制引脚 VCON 上的电压,在无需外部反馈电阻器的情况下,可在 0.6V 至 4.2V 之间动态地设定输出电压。LM3269 的快速输出电压瞬态响应使得此器件适合用来根据其传输功率来自适应调整 PA 电源电压,这样延长了电池寿命。

额外的特性包括电流过载保护、输出过压钳位和热过载关断。

LM3269 采用芯片级 12 凸点 DSBGA 封装,此封装为诸如手机应用等电路板面积是重要设计考虑因素的空间有限应用提供最小可能的尺寸。高开关频率的使用(典型值 2.4MHz)减小了外部组件的尺寸。正如典型应用电路中所显示,电路运行只需三个外部电源组件。DSBGA 封装的使用要求在执行时进行特别的设计考虑。(请见 [DSBGA 封装组装和使用](#)) 此封装的精细凸点间距要求仔细的电路板设计和精密组装设备。此封装非常适合于外壳不透明的应用,在此类应用中,其边缘不会受到高强度红色或红外线光照的影响。此外,系统控制应该在加电和其它低电源电压条件下将 EN 设定为低电平。(请见下面的 [使能和关断模式](#)。)

使能和关断模式

将 EN 数字引脚为置为低电平 (<0.6V) 将把 LM3269 置于关断模式(典型值 0.01 μ A)。关断期间,LM3269 的输出为三态,从而保持输出电容器上的电荷存储。将 EN 置为高电平 (>1.2V) 将启用正常运行。当电源 (PVIN) 少于 2.7V 的最小运行电压时,EN 应该被置为低电平来在加电和欠压条件下关闭 LM3269。

V_{CON, ON}

当 VCON 低于 125mV (典型值) 时,此输出被禁用。当 VCON 高于 150mV (典型值) 时,它被启用。此阈值具有大约为 25mV (典型值) 的滞后。

动态可调节输出电压

LM3269 特有一个动态可调输出电压来免除对外部反馈电阻器的需要。通过改变模拟 VCON 引脚上的电压,输出可被设定在 0.6V 至 4.2V 之间。这个特性在只有当话机远离基站或正在进行数据发送时才需峰值功率的手机 RF PA 应用中十分有用。在其它情况下,发送功率可被减少;因此,到 PA 的电源电压可被减少,从而延长了电池寿命。为了在手机应用中实时自适应调整进入 PA 的电源电压,输出电压转换应该足够快以符合 RF 发送信号技术规格。LM3269 在无需从电池电源汲取极大电流的情况下可提供超快速的输出电压转换。对于 1700mA (典型值) 的电流限值,输出电压可在负载阻抗为 11.4 Ω 的情况下在 10 μ s 内从 1.4V 转换为 3.0V。

无缝降压转换

LM3269 特有一个独特的内部电源开关拓扑结构,此结构可提升转换器效率,特别是相对于典型非反相降压-升压转换器而言。LM3269 运行为一个降压转换器或一个升压转换器,这取决于输入和输出电压情况。这在降压和升压运行模式之间创建了一个边界。当输入电池电压接近已设定的输出电压时,转换器自动无缝切换,这样输出电压不会在模式边界产生任何扰动。LM3269 出色的模式转换能力可实现效率最高的低噪声输出。内部反馈环路补偿可在降压、升压和降压-升压转换操作中确保稳定运行。

热过载保护

LM3269 运行一个热过载保护功能,此功能保护此器件自身不受短期误用和过载情况的影响。当结温超过大约 150°C 时,此器件禁止运行。在 PWM 模式中,所有功率 MOSFET 开关被关闭。当温度下降到低于 125°C 时,恢复正常运行。热过载条件下过长时间的运行有可能损坏此器件并被认为是不良的使用方法。

脉冲频率调制 (PFM) 模式

当输出电压少于 1.5V 时,LM3269 进入 PFM 模式,运行时的开关频率和电源电流减少以保持极高效率。在 PFM 模式中,LM3269 将支持高达 120mA (最大值) 的电流。在 PFM 中,如果输出电压超过 1.5V,此器件将自动转换到一个强制的 PWM 运行模式。

应用信息

设定输出电压

LM3269 特有一个由引脚控制的可变输出电压以免除对于外部反馈电阻器的需要。通过设定 VCON 引脚上的电压，可针对一个介于 0.6V 至 4.2V 之间的输出电压来对其进行设定，如以下公式所示。

$$V_{OUT} = 3 \times V_{CON} \quad (1)$$

当 VCON 介于 0.2V 和 1.4V 之间时，输出电压将符合此公式。

输出电流能力

LM3269 负载能力显示在 Table 1 中。

Table 1. 输出电压与 最大输出电流降额间的关系

V _{OUT}	V _{BATT}	最大 I _{OUT} 能力
4.2V	> 3.0V	650mA
	2.7V 至 3.0V	500mA
3.8V	> 3.0V	750mA
	2.7V 至 3.0V	600mA
< 1.5V	2.7V 至 5.5V	120mA (在 PFM 模式下)

推荐的外部组件

电感器选择

对于几乎所有应用，建议使用一个饱和电流额定值超过 1500mA 并且在完全 DC 偏置条件下具有低电感下降的大小为 2.2μH 的电感器。应该使用具有更小 DC 电阻（例如，110mΩ，这取决于电阻器外壳尺寸）的电感器以实现高效率。

Table 2. 推荐的电感器 (2.2μH)

供应商	模型	尺寸 (mm)	I _{SAT} (30% 下降)	I _{RATING} (Δ40°)	DCR
FDK	MIPSZ2520D2R2	2.5 x 2.0 x 1.0	1.5A	1.1A	110mΩ
Murata	LQH2HPN1R0NG0	2.5 x 2.0 x 1.2	2.0A	1.2A	112mΩ
三星	CIG22H2R2MNE	2.5 x 2.0 x 1.2	1.9A	1.6A	116mΩ
TDK	TFM201610A2R2M	2.0 x 1.6 x 1.0	1.7A	1.3A	180mΩ
TOKO	DFE201612C2R2N	2.0 x 1.6 x 1.2	2.1A	1.3A	155mΩ

输入电容器选择

对于大多数应用，建议使用 10μF，6.3V，0603(1608) 陶瓷输入电容器。将输入电容器尽可能放置在靠近器件 PVIN 引脚和 PGND 引脚的位置上。可使用更高的电压额定值来提升输入滤波性能。使用 X7R，X5R 或 B 类；不要使用 Y5V 或 F 类。当选择诸如 0402(1005) 的外壳尺寸时，必须将陶瓷电容器的 DC 电路板特点考虑在内。输入滤波电容器在每个周期的前半部分为 PFET（高侧）开关供电并减少施加在输入电源上的电压纹波。陶瓷电容器的低等效串联电阻 (ESR) 提供输入电压尖峰（由快速电流变化导致）的最佳噪声滤波。

输出电容器选择

将一个 4.7μF 电容器用作输出电容器。建议为滤波器使用诸如 X5R，X7R 的电容器类型。这些类型的电容器针对手机和类似应用提供小尺寸、成本、可靠性和性能之间的最优均衡。Table 3 中列出了推荐的部件号和供应商。在选择电压额定值和电容器外壳尺寸时必须考虑电容器的 DC 偏置特性。当输出电压快速步升和步降时，较小外壳尺寸的输出电容器缓解了电容器的压电振动。然而，它们在 DC 偏置时具有更大比例的下降值。建议为输出使用一个 0603(1608) 外壳尺寸的电容器。对于 RF 功率放大器应用，将 DC-DC 转换器和 RF 功率放大器之间的输出电容器分离开。（建议使用 4.7μF(0402 (1005)) + PA 输入电容器 (0402(1005)/0201(0603))。）最佳电容值分离视应用而定。将所有输出电容器放置在非常靠近它们各自器件的位置上。如果将一个 4.7μF，考虑到 0402(1005) DC 偏压降级和其它耐受，当把 0402(1005) 用作输出电容器时，V_{OUT} 总线上的总体建议实际电容值应该至少为 7μF (4.7μF + PA 去耦合电容值) (请见 Table 4)。

Table 3. 推荐的电容器：

模型	供应商
10μF 用于 C_{IN}	
C1608X5R0J106K (0603)	TDK
CL05A106MQ5NUN (0402)	三星
4.7μF 用作 C_{OUT}	
C1608X5R0J475M (0603)	TDK
CL05A475MQ5NUN (0402)	三星
C1005X5RR0J475M (0402)	TDK

Table 4. 建议的电容值技术规格

总线	最小值 (μ F)	典型值 (μ F)	最大值 (μ F)
PVIN	-	10	-
VOUT	7		10

DSBGA 封装组装和使用

如德州仪器 (TI) 操作说明书 1112 中所述，DSBGA 封装的使用要求专门的电路板布局、精确的安装和仔细的回流焊技术。请参考表面贴装技术 (SMD) 组装注意事项部分。要获得最佳的组装效果，应该使用 PC 电路板上的对齐序号来简化器件的放置。与 DSBGA 封装一起使用的焊垫类型必须为 NSMD (非阻焊层限定) 类型。这意味着阻焊开口大于焊垫尺寸。否则，如果阻焊层与焊垫重叠的话，会形成唇缘。防止唇缘的形成可使器件紧贴电路板表面并避免妨碍贴装。如何进行这一操作的特定说明请参见操作指南 AN-1112 ([SNVA009](#))。

这个用于 LM3269 的 12 凸点封装具有 300 微米焊球。走线进入焊垫的角度应该为 90°以防止在角落深处中积累残渣。最初时，进入每个焊垫的走线应该为 9.5 毫英寸宽，进入长度大约为 5 毫英寸长，来用作散热。然后每条走线应该至其最佳宽度。重要的标准是对称。这样可确保 LM3269 上的焊锡凸点回流焊均匀并可保证此器件的焊接与电路板水平。特别是对于焊点 A3，B3 和 D3 的焊垫应该给予专门关注。由于 PVIN 和 PGND 通常被连接到较大铜焊盘上，不充分的散热会导致这些焊点滞后或者不充分的回流。

DSBGA 封装针对具有红色或红外不透明外壳应用的最小可能尺寸进行了优化。由于 DSBGA 封装缺少较大器件的塑料密封特点，它对于光照很敏感。背面金属镀层和/或环氧树脂涂层，以及正面印刷电路板遮光减少了此敏感性。然而，此封装将裸片边缘暴露在外。特别是 DSBGA 器件对于照射在封装外露裸片边缘的光照 (在红色和红外范围内) 十分敏感。

PCB 布局布线注意事项

概述

PC 电路板布局布线对于成功将一个 DC-DC 转换器设计成一个产品十分关键。适当地规划电路板布局布线将优化 DC-DC 转换器的性能并大大减少对于周围电路的影响，而同时又解决了会对电路板质量和最终产品产量产生负面影响的制造问题。

PCB

糟糕的电路板布局布线会由于造成了走线内的电磁干扰 (EMI)，接地反弹和阻性电压损耗而破坏 DC-DC 转换器和周围电路的性能。错误的信号会被发送给 DC-DC 转换器集成电路 (IC)，从而导致不良稳压或不稳定。糟糕的布局布线也会导致造成 DSBGA 封装和电路板焊垫间不良焊接接点的回流问题。不佳的焊接接点会导致转换器不稳定或性能下降。

能源利用率

在可能的情况下，在功率组件之间使用宽走线并且将多层上的走线对折来大大减少阻性损耗。

电磁干扰 (EMI)

就其本性而言，任何开关转换器都会产生电气噪声。电路板设计人员所面临的挑战就是大大减少、抑制或者减弱此类由开关生成的噪声。诸如 LM3269 的高频开关转换器，在几纳秒的时间内切换安培级电流，相关组件间互连的走线可作为辐射天线。以下提供的指南有助于将 EMI 保持在可耐受的水平内。

为了帮助大大减少辐射噪声：

- 将 LM3269 转换开关、其输入电容器和输出滤波电感器和电容器尽可能的靠近放置，并使得互连走线尽可能的短。
- 排列组件，使得切换电流环路以同一方向旋转。在每个周期的前半部分（降压模式），电流经由 LM3269 和电感器的内部 PFET，从输入滤波电容器流至输出滤波电容器，然后通过接地返回，从而形成一个电流环路。在每个周期的第二部分（降压模式），电流通过 LM3269 的内部同步 NFET，被电感器从接地上拉至输出滤波电容器，然后通过接地返回，从而形成第二个电流环路。所以同一方向的电流旋转防止了两个半周期间的磁场反向并减少了辐射噪声。
- 使电流环路区域尽可能的小。

为了帮助大大减少接地盘内的传导噪声：

- 减少循环流经接地盘的开关电流：使用大量组件侧铜填充作为一个伪接地盘来将 LM3269 的接地凸点块和其输入/输出滤波电容器连接在一起。然后，通过多个导孔将这个铜填充连接到系统接地盘（如果使用了一个的话）。这些多导孔通过为其提供一个低阻抗接地连接来大大减少 LM3269 上的接地反弹。

为了帮助大大减少到 DC-DC 转换器自身电压反馈走线的耦合：

- 将噪声敏感走线，诸如电压反馈路径 (FB)，但是使其远离功率组件之间的嘈杂走线。如果可能的话，将 FB 凸点直接接至 VOUT 凸点。

为了去耦合普通电源线路，串联阻抗可被用来策略性地隔离电路：

- 经由电源走线，利用电路走线所固有的电感来减少功能块间的耦合。
- 将星型连接用于 VBATT 至 PVIN 和 VBATT 至 VBATT_PA (VCC1) 的单独走线。
- 按照电源走线的走向插入一个单铁氧体磁珠可通过允许使用更少的导电电容器来在电路板面积方面提供一个适当的平衡。

制造注意事项

LM3269 封装采用一个 300 微米焊球的 12 凸点 (4x4) 阵列，焊垫间距 0.5mm。几条简单的设计规则将对确保良好的布局布线大有帮助。

- 焊垫尺寸应该为 $0.265 \pm 0.02 \text{ mm}$ 。阻焊开口应该为 $0.375 \pm 0.02 \text{ mm}$ 。
- 作为一个散热途径，用 9.5 毫英寸宽和 5 毫英寸长的走线连接到每个焊垫并逐渐增加每条走线到其最佳宽度。要确保焊锡凸点回流均匀，对称很重要。请参考 TI 操作说明书 AN-1112 DSBGA 晶圆级芯片封装 (SNVA009)。

LM3269 RF 评估板

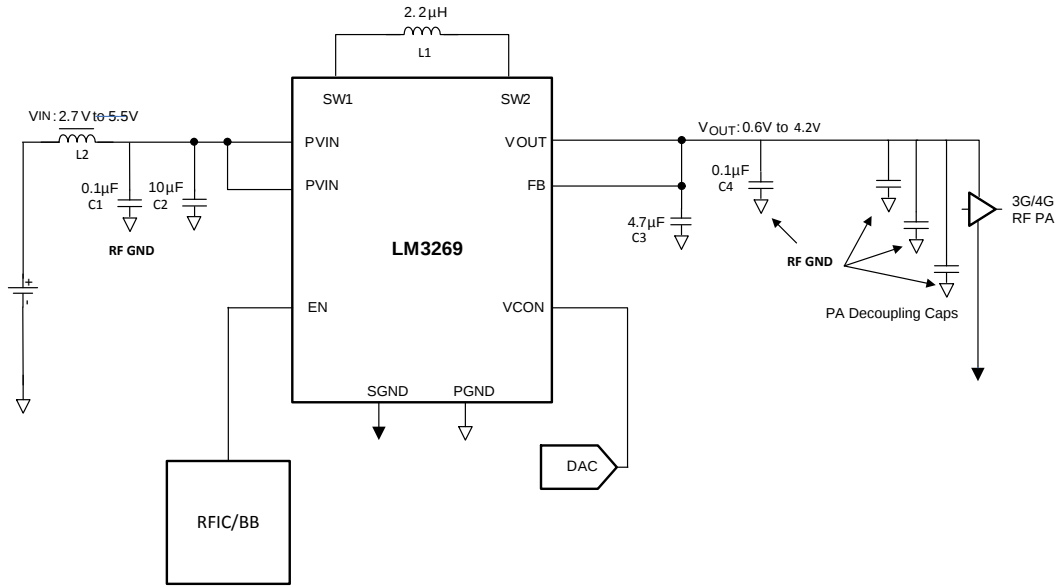


Figure 17. 简化的 LM3269 RF 评估板电路原理图

1. 输入电容器 C2 应该被放置在比 C1 更加靠近 LM3269 的位置上。
2. 为了实现高频滤波，可选择在 LM3269 的输入上添加 100nF (C1)。
3. 大容量输出电容器 C3 应该被放置在比 C4 更加靠近 LM3269 的地方。
4. 要实现高频滤波，可选择在 LM3269 的输出上添加 100nF (C4)。
5. 将 C1 和 C4 的 GND 端子直接接至电话电路板的系统 RF GND 层。
6. 将凸点 SGND (G2) 直接接至系统 GND。
7. 当把小型旁路电容器 (C1 和 C4) 接至系统 GND 而非与 PGND 一样的接地时，TI 已经证明其高频滤波性能的提升。这些电容器应该为 0201 (公制 0603) 外壳尺寸以实现最小封装和最佳高频特性。
8. 一个单铁氧体磁珠 (L2) 有助于改进高频噪声。

Table 5. 推荐组件

指示符	部件号	值	外壳尺寸	供应商
C1*	GMR033R60J104KE19D	0.1µF	0201 (公制 0603)	Murata
C2	C1608X5R0J106	10µF	0603 (公制 1608)	TDK
C3	C1608X5RR0J475M	4.7µF	0603 (公制 1608)	TDK
C4*	GRM033R60J104KE19D	0.1µF	0201 (公制 0603)	Murata
L1	MIPSZ2520D2R2	2.2 µH	1008 (公制 2520)	FDK
L2*	BLM15AX100SN1	10Ω	0402 (公制 1005)	Murata

*可选高频电容器和高频铁氧体磁珠

组件放置

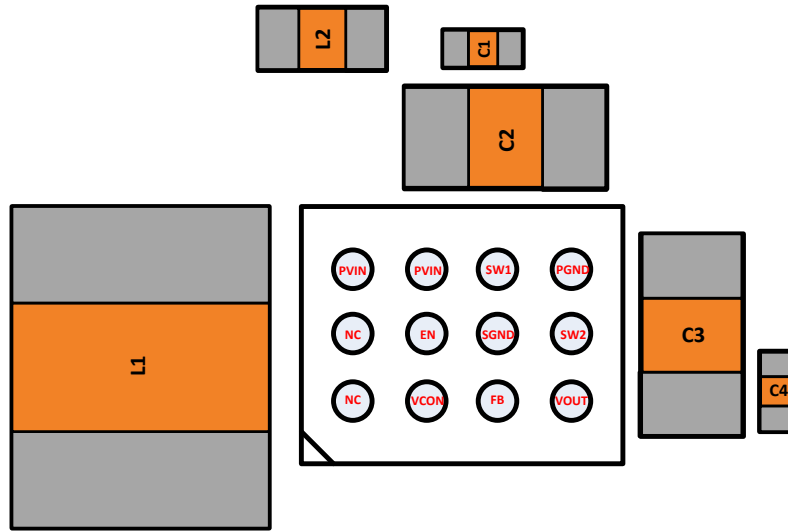


Figure 18. LM3269 推荐部件 (顶视图)

逐层 PCB 注意事项

VBATT

VBATT 至 LM3269 和 VBATT 至 PA VBATT (VCC1) 间使用星型连接。不要将 VBATT 菊花链连接至 LM3269 电路，然后连接至 PA 器件 VBATT 连接。

顶层

1. 如所示，创建一个 PGND 岛。C2 (CIN) 和 C3 (COUT) 的 PGND 垫必须相互隔离。这个 PGND 地岛将由很多导孔连接至专用系统接地。
2. 每个 SW (C3) 和 (D2) 凸点将在焊垫上有一个导孔以及旁边一个额外的导孔，以使 SW 走线下拉至层
3. SGND 凸点 (C2) 在焊垫内有一个导孔，并将其直接接至系统接地。
4. 应将 FB (C1) 直接接至 VOUT 凸点 (D1)。
5. 使 PVIN 导孔挨着可选铁氧体磁珠。
6. 将 NC 凸点 (A1 和 A2) 悬空；不要接至 VBATT 或 GND

第 2 层

7. VCON 和数字逻辑信号可在这层上传递。
8. VOUT (VCC2 或 PA) 可在这层上传递。
9. 用于 LM3269 的 PVIN 可在这层上传递。

第 3 层

10. 每个 SW 走线都在这层上路由。针对电流能力，每条走线的宽度应该为 15 毫英寸 (0.381mm)。使用两个导孔将 SW 走线上拉至电感器焊垫。

第 4 层

11. 连接这个层上的顶层 PGND，SGND 和 高频导孔。

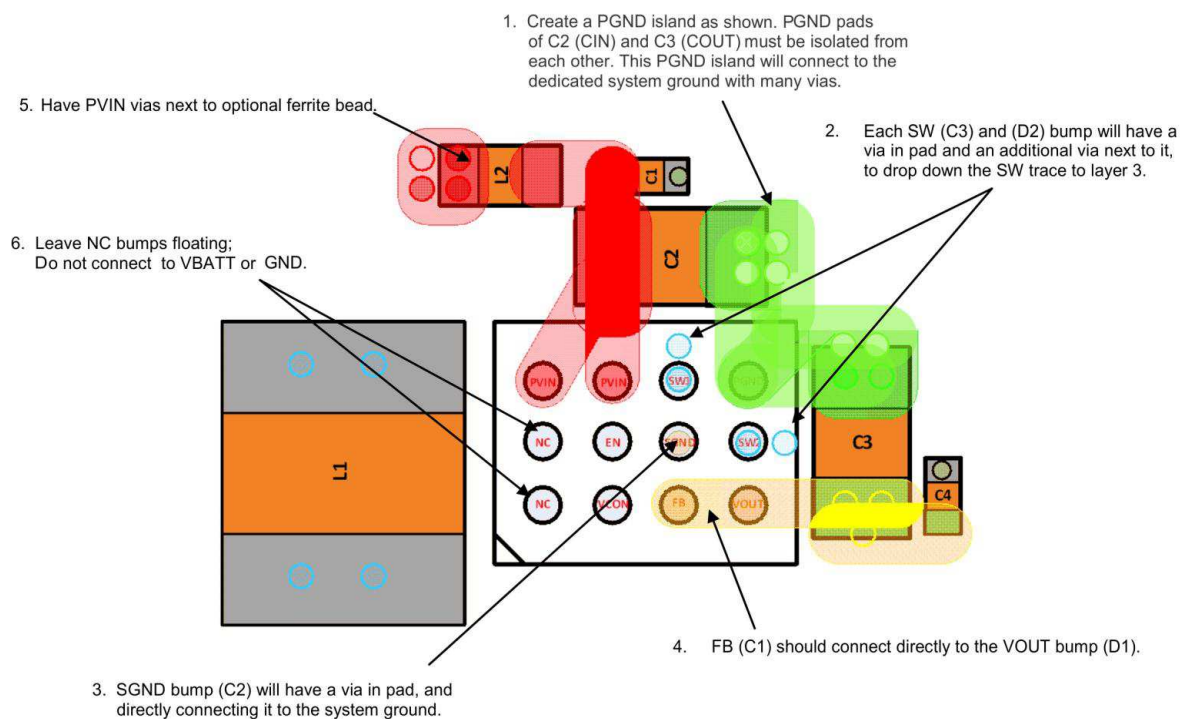


Figure 19. 顶层

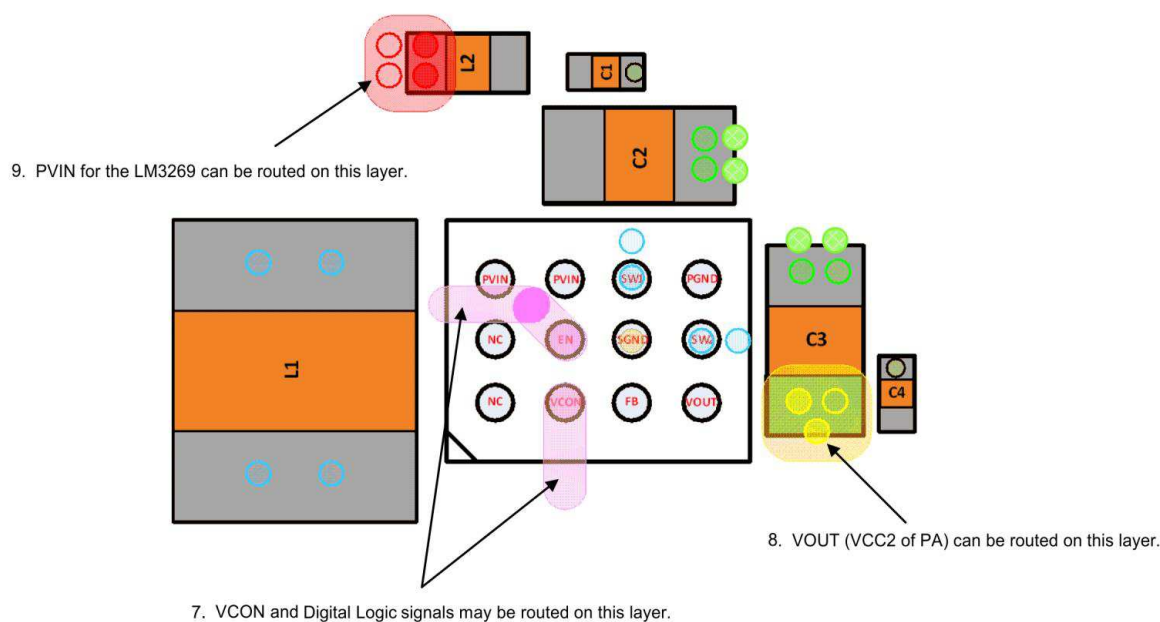


Figure 20. 电路板第2层-逻辑和 PVIN 走线

10. Each SW trace is routed on this layer. The width of each trace should be 15 mils (0.381 mm.) for current capabilities. Have two vias bring each SW trace up to the inductor pads.

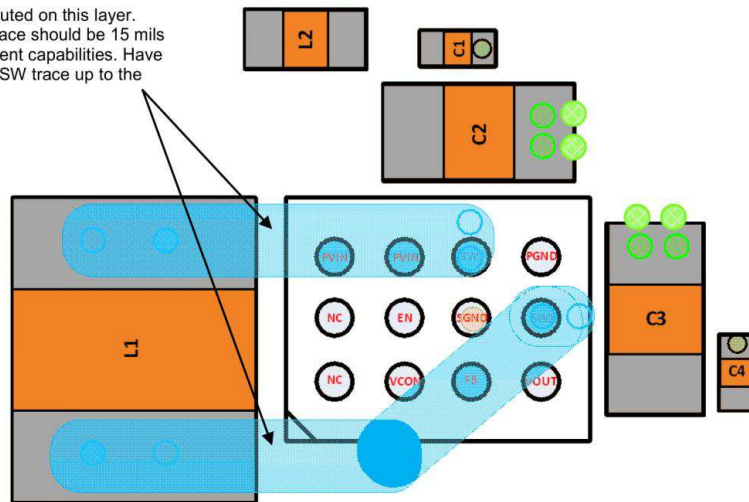


Figure 21. 电路板第 3 层-SW 走线

11. Connect the PGND, SGND, and high Frequency vias from the top layer on this layer.

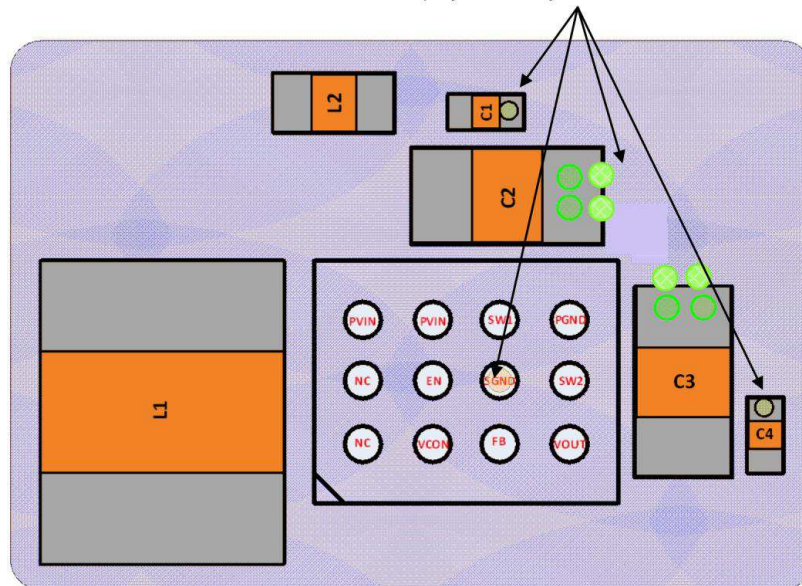


Figure 22. 电路板第 4 层-系统

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead/Ball Finish	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
LM3269TLE/NOPB	ACTIVE	DSBGA	YZR	12	250	Green (RoHS & no Sb/Br)	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-30 to 85	3269	Samples
LM3269TLX/NOPB	ACTIVE	DSBGA	YZR	12	3000	Green (RoHS & no Sb/Br)	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-30 to 85	3269	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) Eco Plan - The planned eco-friendly classification: Pb-Free (RoHS), Pb-Free (RoHS Exempt), or Green (RoHS & no Sb/Br) - please check <http://www.ti.com/productcontent> for the latest availability information and additional product content details.

TBD: The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.

Pb-Free (RoHS): TI's terms "Lead-Free" or "Pb-Free" mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all 6 substances, including the requirement that lead not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.

Pb-Free (RoHS Exempt): This component has a RoHS exemption for either 1) lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package, or 2) lead-based die adhesive used between the die and leadframe. The component is otherwise considered Pb-Free (RoHS compatible) as defined above.

Green (RoHS & no Sb/Br): TI defines "Green" to mean Pb-Free (RoHS compatible), and free of Bromine (Br) and Antimony (Sb) based flame retardants (Br or Sb do not exceed 0.1% by weight in homogeneous material)

(3) MSL, Peak Temp. -- The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM3269TLE/NOPB	DSBGA	YZR	12	250	178.0	8.4	2.18	2.69	0.76	4.0	8.0	Q1
LM3269TLX/NOPB	DSBGA	YZR	12	3000	178.0	8.4	2.18	2.69	0.76	4.0	8.0	Q1

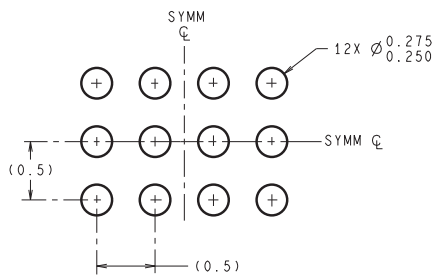
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



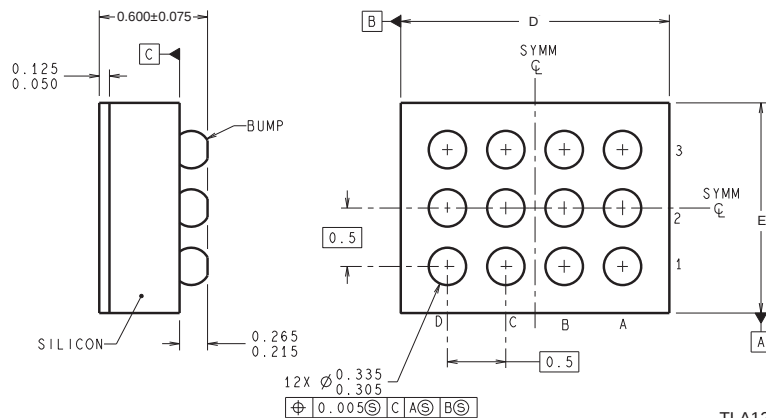
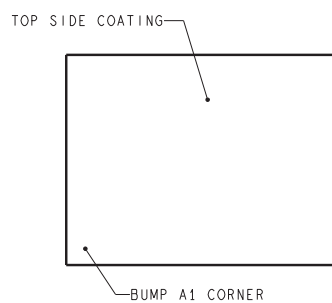
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM3269TLE/NOPB	DSBGA	YZR	12	250	210.0	185.0	35.0
LM3269TLX/NOPB	DSBGA	YZR	12	3000	210.0	185.0	35.0

YZR0012



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
DIMENSIONS IN () FOR REFERENCE ONLY

LAND PATTERN RECOMMENDATION

TLA12XXX (Rev C)

D: Max = 2.529 mm, Min = 2.469 mm

E: Max = 2.022 mm, Min = 1.961 mm

4215049/A 12/12

NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
B. This drawing is subject to change without notice.

重要声明

德州仪器 (TI) 公司有权按照最新发布的 JESD46 对其半导体产品和服务进行纠正、增强、改进和其他修改，并不再按最新发布的 JESD48 提供任何产品和服务。买方在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。

TI 公布的半导体产品销售条款 (<http://www.ti.com/sc/docs/stdterms.htm>) 适用于 TI 已认证和批准上市的已封装集成电路产品的销售。另有其他条款可能适用于其他类型 TI 产品及服务的使用或销售。

复制 TI 数据表上 TI 信息的重要部分时，不得变更该等信息，且必须随附所有相关保证、条件、限制和通知，否则不得复制。TI 对该等复制文件不承担任何责任。第三方信息可能受到其它限制条件的制约。在转售 TI 产品或服务时，如果存在对产品或服务参数的虚假陈述，则会失去相关 TI 产品或服务的明示或暗示保证，且构成不公平的、欺诈性商业行为。TI 对此类虚假陈述不承担任何责任。

买方和在系统中整合 TI 产品的其他开发人员（总称“设计人员”）理解并同意，设计人员在设计应用时应自行实施独立的分析、评价和判断，且应全权负责并确保应用的安全性，及设计人员的应用（包括应用中使用的 TI 产品）应符合所有适用的法律法规及其他相关要求。设计人员就自己设计的应用声明，其具备制订和实施下列保障措施所需的一切必要专业知识，能够 (1) 预见故障的危险后果，(2) 监视故障及其后果，以及 (3) 降低可能导致危险的故障几率并采取适当措施。设计人员同意，在使用或分发包含 TI 产品的任何应用前，将彻底测试该等应用和该等应用中所用 TI 产品的功能。

TI 提供技术、应用或其他设计建议、质量特点、可靠性数据或其他服务或信息，包括但不限于与评估模块有关的参考设计和材料（总称“TI 资源”），旨在帮助设计人员开发整合了 TI 产品的应用，如果设计人员（个人，或如果是代表公司，则为设计人员的公司）以任何方式下载、访问或使用任何特定的 TI 资源，即表示其同意仅为该等目标，按照本通知的条款使用任何特定 TI 资源。

TI 所提供的 TI 资源，并未扩大或以其他方式修改 TI 对 TI 产品的公开适用的质保及质保免责声明；也未导致 TI 承担任何额外的义务或责任。TI 有权对其 TI 资源进行纠正、增强、改进和其他修改。除特定 TI 资源的公开文档中明确列出的测试外，TI 未进行任何其他测试。

设计人员只有在开发包含该等 TI 资源所列 TI 产品的应用时，才被授权使用、复制和修改任何相关 TI 资源。但并未依据禁止反言原则或其他法律授予您任何 TI 知识产权的任何其他明示或默示的许可，也未授予您 TI 或第三方的任何技术或知识产权的许可，该等许可包括但不限于任何专利权、版权、屏蔽作品权或与美国 TI 产品或服务的任何整合、机器制作、流程相关的其他知识产权。涉及或参考了第三方产品或服务的信息不构成使用此类产品或服务的许可或与其相关的保证或认可。使用 TI 资源可能需要您向第三方获得对该等第三方专利或其他知识产权的许可。

TI 资源系“按原样”提供。TI 兹免除对资源及其使用作出所有其他明确或默示的保证或陈述，包括但不限于对准确性或完整性、产权保证、无屡发故障保证，以及适销性、适合特定用途和不侵犯任何第三方知识产权的任何默认保证。TI 不负任何责任，包括但不限于因组合产品所致或与之有关的申索，也不为或对设计人员进行辩护或赔偿，即使该等产品组合已列于 TI 资源或其他地方。对因 TI 资源或其使用引起或与之有关的任何实际的、直接的、特殊的、附带的、间接的、惩罚性的、偶发的、从属或惩戒性损害赔偿，不管 TI 是否获悉可能会产生上述损害赔偿，TI 概不负责。

除 TI 已明确指出特定产品已达到特定行业标准（例如 ISO/TS 16949 和 ISO 26262）的要求外，TI 不对未达到任何该等行业标准要求而承担任何责任。

如果 TI 明确宣称产品有助于功能安全或符合行业功能安全标准，则该等产品旨在帮助客户设计和创作自己的符合相关功能安全标准和要求的的应用。在应用内使用产品的行为本身不会配有安全特性。设计人员必须确保遵守适用于其应用的相关安全要求和标准。设计人员不可将任何 TI 产品用于关乎性命的医疗设备，除非已由各方获得授权的管理人员签署专门的合同对此类应用专门作出规定。关乎性命的医疗设备是指出现故障会导致严重身体伤害或死亡的医疗设备（例如生命保障设备、心脏起搏器、心脏除颤器、人工心脏泵、神经刺激器以及植入设备）。此类设备包括但不限于，美国食品药品监督管理局认定为 III 类设备的设备，以及在美国以外的其他国家或地区认定为同等类别设备的所有医疗设备。

TI 可能明确指定某些产品具备某些特定资格（例如 Q100、军用级或增强型产品）。设计人员同意，其具备一切必要专业知识，可以为自己的应用选择适合的产品，并且正确选择产品的风险由设计人员承担。设计人员单方面负责遵守与该等选择有关的所有法律或监管要求。

设计人员同意向 TI 及其代表全额赔偿因其不遵守本通知条款和条件而引起的任何损害、费用、损失和/或责任。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2017 德州仪器半导体技术（上海）有限公司